



ภาคผนวก ข-10

ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

เอกสารหมายเลข 5

ที่...../.....

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขออนุญาตใช้ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

เรียน ผู้จัดการทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียด - มาตรการการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด
 2. แบบคำนวณพร้อมรายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด
 3. แบบพิมพ์เขียวของระบบบำบัดน้ำเสีย (Flow Diagram For Waste Water Treatment System) จำนวน 1 ชุด
 4. แบบพิมพ์เขียวแสดงแผนผังโรงงาน (Site Plan For Factory) จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทาง บริษัท. [REDACTED] จำกัด

ได้เข้ามาก่อสร้างโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ณ แปลงที่ดินเลขที่ 11 และ 12

เป็นเนื้อที่ 36 ไร่ 3 งาน 40-39 ตารางวา บัดนี้ ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ขอ
อนุญาตระบายน้ำเสียหลังจากบำบัดได้ตามมาตรฐานที่ทางนิคมฯ กำหนด ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พร้อมกัน
นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อทางนิคมฯ พิจารณาอนุญาตต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

[REDACTED]
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

หมายเหตุ : จัดทำหลังจากก่อสร้างเสร็จโดยลูกค้า, พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียด – มาตรการ
การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน

- 1.1) ชื่อโรงงาน – บริษัท [REDACTED]
1.2) พื้นที่ก่อสร้างโรงงาน : [REDACTED]ตารางวา
1.3) จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะมีทั้งหมด..... 300คน
1.4) กิจการ – หรือการผลิต
.....แผ่นโซลาร์เซลล์
.....

2.) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำ

- 2.1) ปริมาณที่คาดว่าจะใช้จริง เมื่อขบวนการผลิตดำเนินการเต็มที่
2.2.1) ปริมาณน้ำที่ใช้ในขบวนการผลิต..... 2500ลบ.เมตร/วัน
2.2.2) ปริมาณน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค..... 50ลบ.เมตร/วัน
2.2) ปริมาณน้ำเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อขบวนการผลิตดำเนินการเต็มที่
2.2.1) ปริมาณน้ำที่ใช้ในขบวนการผลิต..... 1800ลบ.เมตร/วัน
2.2.2) ปริมาณน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค..... 50ลบ.เมตร/วัน
2.2.3) ปริมาณน้ำเสียรวม..... 1850ลบ.เมตร/วัน
2.3) ขบวนการผลิตของโรงงานแบ่งเป็นขั้นตอนการผลิต ดังนี้
(กรุณาเขียนเป็น Flow Diagram แบบง่าย ๆ เพื่อการเข้าใจที่ง่าย พร้อมทั้ง
เขียนรายละเอียดประกอบทุกขั้นตอนการผลิต – กรุณาเขียนในหน้าถัดไป)

ประเภท และปริมาณการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

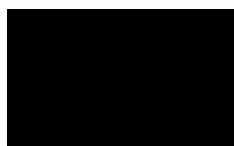
ลำดับที่	ชื่อสารเคมี	ปริมาณการใช้(กก./เดือน)
1	additive	7211.88
2	additive	9648
3	HF	52008.75
4	HCL	24676.2072
5	HNO3	1603.98
6	KOH	108966.924
7	NaOH	0
8	H2O2	168,001.83

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

- 1.) บริษัทของท่านมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นหรือไม่..... มี
- 2.) ประเภทของระบบบำบัดเบื้องต้น :
- 3.) กรุณาเขียนบรรยายวิธีการบำบัดน้ำเบื้องต้นของระบบที่ท่านแจ้ง (ถ้าเนื้อหาไม่พอให้เขียนในหน้าถัดไป)

หากท่านมีเอกสารประกอบ หรือ รายละเอียดที่เตรียมไว้แล้วเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ท่านสามารถแนบเอกสารดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเขียนบรรยายอีก

	210P-单晶背钝化 1.4GW 210BOM-3条线			单位	泰国项目 210尺寸, 单晶PERC 路线	
单日最大 产量	402			K片	1.4GW, 研 发BOM	
	工序	名称	每千片耗量	单位	耗量L/天 1.4GW	kg/月
P-perc	全部化学品 种类	制绒添加剂 additive	0.598	L	240.40	7211.88
		碱抛添加剂 additive	0.800	L	321.60	9648
		氢氟酸 HF	3.750	L	1507.50	52008.75
		盐酸 HCL	1.734	L	697.07	24676.207
		硝酸 HNO3	0.095	L	38.19	1603.98
		氢氧化钾 KOH	6.105	L	2454.21	108966.92
		氢氧化钠 NaOH	0.000	L	0.00	0
		过氧化氢 H2O2	12.550	L	5045.10	168001.83
汇总			L	10304.06		
注：以上按照最大产能设计最大的用量。						



厂区污水汇总		
废水分类收集	污染物种类	收集水量 (m ³ /day)
P1	一般酸碱 (含稀 HF、HNO ₃ 、HCl)	1443
P2	浓碱 (含浓: NaOH、H ₂ O ₂)	127
P3	浓酸 (含浓: HNO ₃ 、HCl、HF、O ₃)	121
P1	酸雾塔排水 (含稀 HF、HNO ₃ 、HCl)	100
P4	硅烷塔排水 (含高氨氮废水)	30
P5	生活污水 (卫生间排水、食堂污水) 含有机物, 氨氮 SS 等	直排管网
合计		1821



Detail of Calculation

1. General acid and alkali Wastewater Transfer Tank 1

-Flow rate	21.77 m ³ /hr
-Design dimension	71.05 m ² A×3.00 mH
-Free board	1.0 m
-Effective volume	142.10 m ³
-Effective HRT	6.53 hr

2. Concentrated Alkali Wastewater Transfer Tank 1

-Flow rate	2.88 m ³ /hr
-Design dimension	5.20 mW×1.25 mL×3.00 mH
-Free board	1.0 m
-Effective volume	13.00 m ³
-Effective HRT	4.52 hr

3. Concentrated acid Wastewater Transfer Tank 1

-Flow rate	2.65 m ³ /hr
-Design dimension	Φ2.30 m×2.40 mH
-Free board	0.5 m
-Effective volume	10.00 m ³
-Effective HRT	3.77 hr

4. General acid and alkali Wastewater Transfer Tank 2

-Flow rate	42.53 m ³ /hr
-Design dimension	65.36 m ² A×3.50 mH
-Free board	1.0 m
-Effective volume	163.40 m ³
-Effective HRT	3.84 hr

5. Concentrated Alkali Wastewater Transfer Tank 2

-Flow rate	2.44 m ³ /hr
-Design dimension	5.75 mW×1.30 mL×3.50 mH
-Free board	1.0 m

-Effective volume 18.69 m³

-Effective HRT 7.67 hr

6. Concentrated acid Wastewater Transfer Tank 2

-Flow rate 2.41 m³/hr

-Design dimension $\Phi 2.30 \text{ m} \times 2.40 \text{ mH}$

-Free board 0.5 m

-Effective volume 10.00 m³

-Effective HRT 4.15 hr

7. Ammonia absorption tower Wastewater Transfer Tank

-Flow rate 1.25 m³/hr

-Design dimension $\Phi 2.76 \text{ m} \times 2.60 \text{ mH}$

-Free board 0.5 m

-Effective volume 15.00 m³

-Effective HRT 12.00 hr

8. Concentrated acid Wastewater Collection Tank

-Flow rate 5.04 m³/hr

-Design dimension 5.00 mW \times 4.00 mL \times 6.00 mH

-Free board 0.5 m

-Effective volume 110.00 m³

-Effective HRT 21.82 hr

9. Concentrated Alkali Wastewater Collection Tank

-Flow rate 5.29 m³/hr

-Design dimension 5.00 mW \times 4.00 mL \times 6.00 mH

-Free board 0.5 m

-Effective volume 110.00 m³

-Effective HRT 20.79 hr

10. NH₃-N Wastewater Collection Tank

-Flow rate 1.25 m³/hr

-Design dimension 2.75 mW \times 8.00 mL \times 6.00 mH

-Free board	0.5 m
-Effective volume	132.00 m ³
-Effective HRT	96.80 hr

11. Reserved Tank

-Flow rate	6.25 m ³ /hr
-Design dimension	2.25 mW×8.00 mL×6.00 mH
-Free board	0.5 m
-Effective volume	99.00 m ³
-Effective HRT	15.84 hr

12. RO Concentrated Water Collection Tank (Reserved tank)

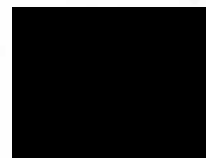
-Flow rate	/
-Design dimension	4.50 mW×4.00 mL×6.00 mH
-Free board	0.5 m
-Effective volume	99.00 m ³
-Effective HRT	/

13. Power Room ditch Wastewater Collection Tank

-Flow rate	20.83 m ³ /hr
-Design dimension	4.50 mW×4.00 mL×6.00 mH
-Free board	0.5 m
-Effective volume	99.00 m ³
-Effective HRT	4.75 hr

14. Regulating Tank

-Flow rate	75.88 m ³ /hr
-Design dimension	9.00 mW×14.50 mL×6.00 mH
-Free board	0.5 m
-Effective volume	717.75 m ³
-Effective HRT	9.46 hr



15. Emergency Tank

-Flow rate	75.88 m ³ /hr
-Design dimension	7.00 mW×14.50 mL×6.00 mH
-Free board	0.5 m
-Effective volume	558.25 m ³
-Effective HRT	7.36 hr

16. First stage Defluorination reaction tank 1

-Flow rate	83.33 m ³ /hr
-Design dimension	4.50 mW×5.00 mL×5.50 mH
-Free board	0.5 m
-Effective volume	112.50 m ³
-Effective HRT	1.35 hr

17. First stage Defluorination reaction tank 2

-Flow rate	83.33 m ³ /hr
-Design dimension	4.50 mW×5.00 mL×5.50 mH
-Free board	0.5 m
-Effective volume	112.50 m ³
-Effective HRT	1.35 hr

18. First stage Defluorination reaction tank 3

-Flow rate	83.33 m ³ /hr
-Design dimension	2.50 mW×2.50 mL×5.50 mH
-Free board	0.5 m
-Effective volume	31.25 m ³
-Effective HRT	0.38 hr

19. First stage Defluorination reaction tank 4

-Flow rate	83.33 m ³ /hr
-Design dimension	2.50 mW×2.50 mL×5.50 mH
-Free board	0.5 m
-Effective volume	31.25 m ³

-Effective HRT 0.38 hr

20. First stage Sedimentation Tank

-Flow rate 83.33 m³/hr

-Design dimension $\Phi 11.50 \text{ m} \times 5.50 \text{ mH}$

-Free board 0.5 m

-Effective volume 661.25 m³

-Effective HRT 7.94 hr

-Effective overflow rate 0.63 m³/m²-day

21. Second stage Defluorination reaction tank 1

-Flow rate 83.33 m³/hr

-Design dimension 4.50 mW \times 5.00 mL \times 5.00 mH

-Free board 0.5 m

-Effective volume 101.25 m³

-Effective HRT 1.22 hr

22. Second stage Defluorination reaction tank 2

-Flow rate 83.33 m³/hr

-Design dimension 4.50 mW \times 5.00 mL \times 5.00 mH

-Free board 0.5 m

-Effective volume 101.25 m³

-Effective HRT 1.22 hr

23. Second stage Defluorination reaction tank 3

-Flow rate 83.33 m³/hr

-Design dimension 2.50 mW \times 2.50 mL \times 5.00 mH

-Free board 0.5 m

-Effective volume 28.13 m³

-Effective HRT 0.34 hr

24. Second stage Defluorination reaction tank 4

-Flow rate 83.33 m³/hr

-Design dimension 2.50 mW \times 2.50 mL \times 5.00 mH

-Free board	0.5 m
-Effective volume	28.13 m ³
-Effective HRT	0.34 hr

25. Second stage Sedimentation Tank

-Flow rate	83.33 m ³ /hr
-Design dimension	Φ11.50 m×5.00 mH
-Free board	0.5 m
-Effective volume	595.13 m ³
-Effective HRT	7.14 hr
-Effective overflow rate	0.63 m ³ /m ² -day

26. Discharge Tank

-Flow rate	83.33 m ³ /hr
-Design dimension	5.00 mW×7.50 mL×5.00 mH
-Free board	1.00 m
-Effective volume	150.00 m ³
-Effective HRT	1.80 hr

27. Calcium Fluoride Sludge Tank1

-Flow rate	4.50 m ³ /hr
-Design dimension	4.50 mW×5.00 mL×5.00 mH
-Free board	0.50 m
-Effective volume	101.25 m ³
-Effective HRT	22.51 hr

28. Calcium Fluoride Sludge Tank2 (Phase ii reserved)

-Flow rate	/
-Design dimension	4.50 mW×5.00 mL×5.00 mH
-Free board	0.50 m
-Effective volume	101.25 m ³
-Effective HRT	/

29. Lime Slurry Storage Tank

-Flow rate	6 m ³ /hr
-Design dimension	5.00 mW×3.75 mL×3.50 mH
-Free board	0.50 m
-Effective volume	60.00 m ³
-Effective HRT	248.83 hr

30. CaCl₂ Storage Tank

-Flow rate	16 m ³ /hr
-Design dimension	3.25 mW×10.00 mL×3.50 mH
-Free board	0.50 m
-Effective volume	104.00 m ³
-Effective HRT	158.25 hr

31. PAC Storage Tank

-Flow rate	3 m ³ /hr
-Design dimension	5.00 mW×3.75 mL×3.50 mH
-Free board	0.50 m
-Effective volume	56.25 m ³
-Effective HRT	432.69 hr

32. NaoH Storage Tank

-Flow rate	/
-Design dimension	Φ3.40 m×3.30 mH
-Free board	0.50 m
-Effective volume	30 m ³
-Effective HRT	/

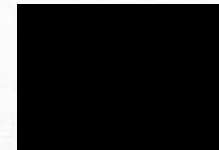
33. H₂SO₄ Storage Tank

-Flow rate	/
-Design dimension	Φ3.40 m×3.30 mH
-Free board	0.50 m
-Effective volume	30 m ³
-Effective HRT	/

Process Flow 工艺流程	step1	step2	step3	step4	step5
	Texturing制绒	Diffusion扩散	SE:SelectiveEmitter(选择性发射极)	Etch polishing碱抛三合一	退火: annealing
Description描述	<p>Texturing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the mechanical damage layer on the surface of the silicon wafer 2. Remove surface oil and metal impurities 3. Form undulating suede, reduce sunlight reflection, reduce refractive index, and increase the absorption of sunlight by silicon wafers <p>制绒:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、去除硅片表面的机械损伤层 2、清除表面油污和金属杂质 3、形成起伏不平的绒面,减少太阳光反射,降低折射率,增加硅片对太阳光的吸收 	<p>Diffusion:</p> <p>In the diffusion process, POCl₃ is decomposed under high temperature and generates phosphorus. Then, the phosphorus diffuses on the P-type substrate to form a PN junction.</p> <p>扩散: 通过高温扩散,在P型硅片表面扩散形成N层,制备PN结(太阳能电池的核心)</p>	<p>SE (SelectiveEmitter) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Heavy doping (low square resistance) in the electrode contact area to form a good contact, in order to increase the open circuit voltage and short circuit current at the same time, and not reduce the fill factor, selectively in the electrode contact part Heavy doping is performed, and light doping is performed between the electrodes; 2. Shallow doping (high square resistance) in the non-electrode region to form a good spectral response <p>SE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在电极接触区域重掺杂(低方阻),形成良好的接触,为了同时提高开路电压和短路电流,并且不降低填充因子,选择性的在电极接触部位进行重掺杂,在电极之间位置进行轻掺杂; 2、在非电极区域浅掺杂(高方阻),形成好的光谱响应 	<p>Etch polishing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oxidation: The silicon dioxide layer is grown on the front side, and the silicon dioxide and the front side phosphosilicate glass are used to ensure that the front side is not corroded, and the purpose is to protect the front side PN junction 2. Removal of phosphosilicate glass: remove phosphosilicate glass on the back, and add water film on the front to protect the front phosphosilicate glass from being damaged 3. Etching: use additives to protect the front side of the silicon wafer, use sodium hydroxide solution to etch the back side, etch the backside pyramid formed by texturing, improve the backside reflectivity, and at the same time enhance the absorption of long-wave light <p>碱抛三合一:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、氧化: 正面生长氧化硅层,利用氧化硅和PSG,保证正面不被腐蚀,目的保护PN结 2、去PSG: 去除背面磷硅玻璃,正面加水膜保护正面PSG不被破坏 3、刻蚀: 利用添加剂对硅片进行正面保护,利用氢氧化钠溶液对背面进行刻蚀,将制绒形成的背面金字塔腐蚀平整,提高背面反射率,同时增 	<p>Oxygen is passed through the silicon surface at high temperature to form a SiO₂ film on the surface of the silicon wafer. The SiO₂ film has a passivation effect, which can effectively prevent the recombination of carriers at the surface and improve the conversion efficiency of the cell.</p> <p>退火: 高温条件下在硅表面通氧气,在硅片表面形成SiO₂膜, SiO₂膜有钝化作用,可以有效地阻止载流子在表面处的复合,提高电池片的转换效率</p>
使用物料use material	<p>NaOH: 氢氧化钠</p> <p>H₂O₂:双氧水</p> <p>Texturing additives:制绒添加剂</p> <p>Efficient cleaning agent: 降低双氧水添加剂(高效清洗剂)</p> <p>HF: 氢氟酸</p> <p>HCL: 盐酸</p> <p>O₂:氧气</p> <p>HNO₃:硝酸(返工不良品清洗使用)</p>	<p>POCl₃:三氯氧磷</p> <p>N₂:氮气</p> <p>O₂:氧气</p>	/	<p>NaOH: 氢氧化钠</p> <p>H₂O₂:双氧水</p> <p>Etch additives:碱抛添加剂</p> <p>HF: 氢氟酸</p> <p>HCL: 盐酸</p> <p>O₂:氧气</p>	<p>N₂:氮气</p> <p>O₂:氧气</p>

PECVD正膜+G6:J6+A1
Solar Cell Process Flow with PERC (Passivated Emitter Rear Cell)

Process Flow 工艺流程	step6 ALD	step7 PECVD正膜	step8 PECVD背膜	step9 Laser Opening激光开槽	step10 Screen Printing and Sintering丝网印刷烧结	step11 Testing测试分选
Description描述	A layer of aluminum oxide is deposited on the back surface by atomic layer deposition technique.It can work as back surface passivation ALD: 原子层沉积 (Atomic Layer deposition) 是一种基于表面气相化学反应的薄膜沉积技术。通过原子层沉积技术在背面沉积一层氧化铝,可以对硅片背表面进行钝化	In order to ensure the wafer have excellent chemical stability and isolation properties. Microwave or radiofrequency technology is applied to ionize the reacting gases. Which deposit a thin film on the wafer. PECVD:采用等离子体增强化学气相沉淀技术在电池表面沉淀一层氮化硅减反射膜,增强对光的吸收性,对太阳能电池起到表面和体内钝化作用。	Microwave or radiofrequency technology is applied to ionize the reacting gases. A layer of silicon nitride coating is deposited on the Al2O3 layer. It will protect aluminum oxide layer. PECVD:采用等离子体增强化学气相沉淀技术在氧化铝表面沉淀一层氮化硅薄膜保护氧化铝。	Remove the insulation layer (Al2O3+SIN) according to the pattern. The paste can contact the wafer to conduct rear side current. 激光: 去除绝缘层 (Al2O3 + SIN)。浆料可以接触硅基底以传导背面电流。	Screen Printing:A patterned template attached to a screen is used for printing. Sintering: this process will change the electron free energy from unstable position to stable position.丝网印刷:利用丝网印刷技术,分别在硅片背面正面制备背电极(银浆)背电场(铝浆)正电极(银浆),与硅片表面形成良好的欧姆接触。	Testing:Based on the output characteristics, figure out the optimal work Voc(open circuit voltage) and Isc(short circuit current). Sorting: At last, cells are classified according to their efficiency and current. 测试分选: 模拟太阳光照原理对电池片进行效率功率进行分档测试,并根据外观颜色、缺陷进行自动分类。
使用物料use material	TMA:三甲基铝 N2:氮气	SiH4:硅烷 NH3:氨气 N2: 氮气 N2O: 笑气	SiH4:硅烷 NH3:氨气 N2: 氮气 N2O: 笑气	/	背银浆料: Back silver paste 背铝浆料: Aluminum paste 正银浆料: Front silver paste 背极网版: Back busbar screen 背场网版: Back print screen 主栅网版: Front busbar screen 细栅网版: Front Finger screen 刮刀: squeegee	/





序号	图 例	名 称
1		建筑物及层数
2		道路及交叉点坐标、标高
3		停车位及厂区绿化
4		室内、外标高
5		建筑控制线
6		用地红线

总图主要技术经济指标

序号	项目名称	单位	数 据	备 注
1	用地面积	m ²	58961.65	合88.44亩
2	总建筑面积	m ²	31576.39	
3	计容积率	m ²	55848.85	
4	容积率		0.95	
5	建筑密度占面积	m ²	30420.25	
6	建筑密度	%	51.59	
7	绿地面积	m ²	9566.36	
8	绿地率	%	16.22	
9	围墙长度	m	947	

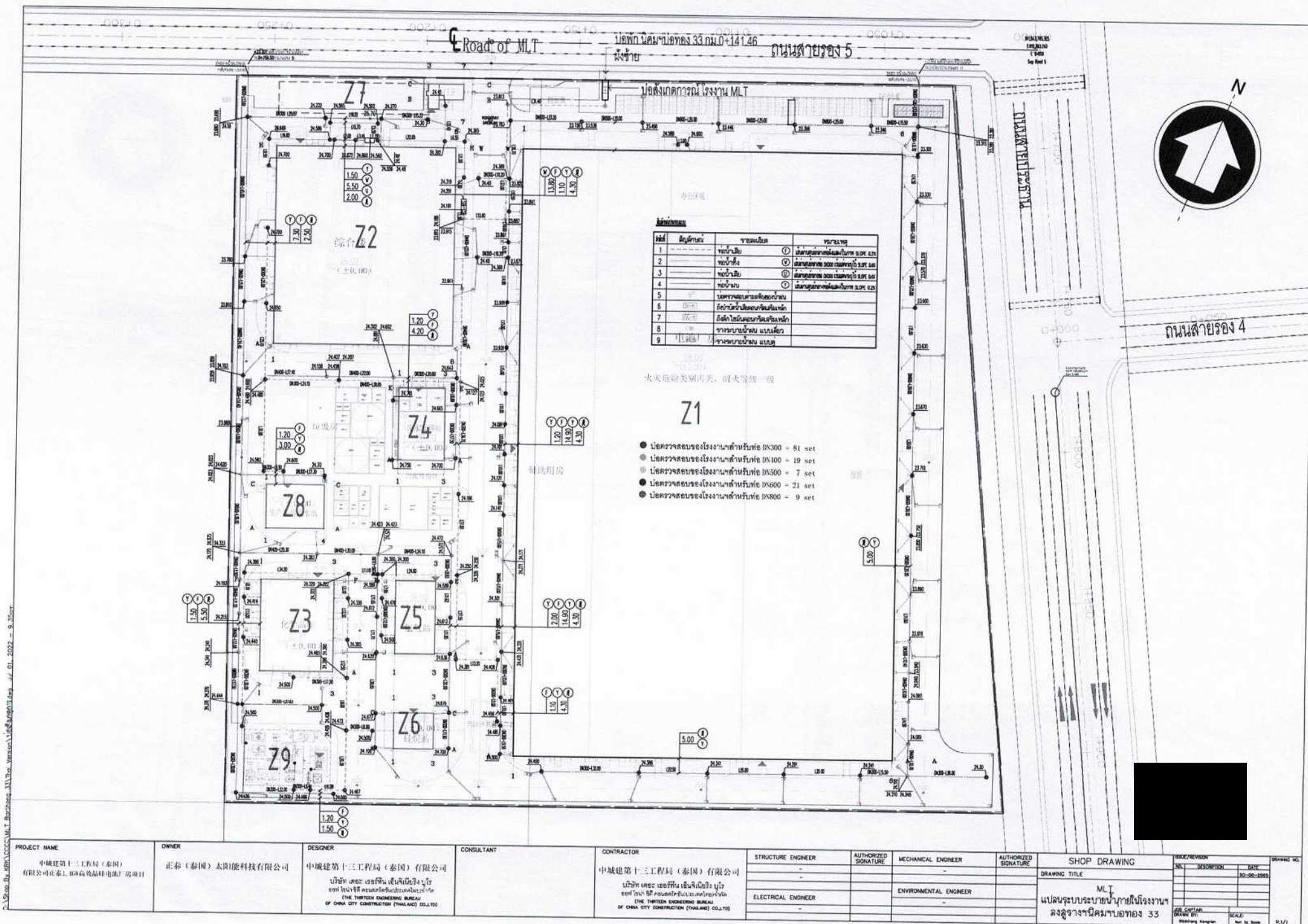
*二層高大于8m,計算高度應按層數加倍。

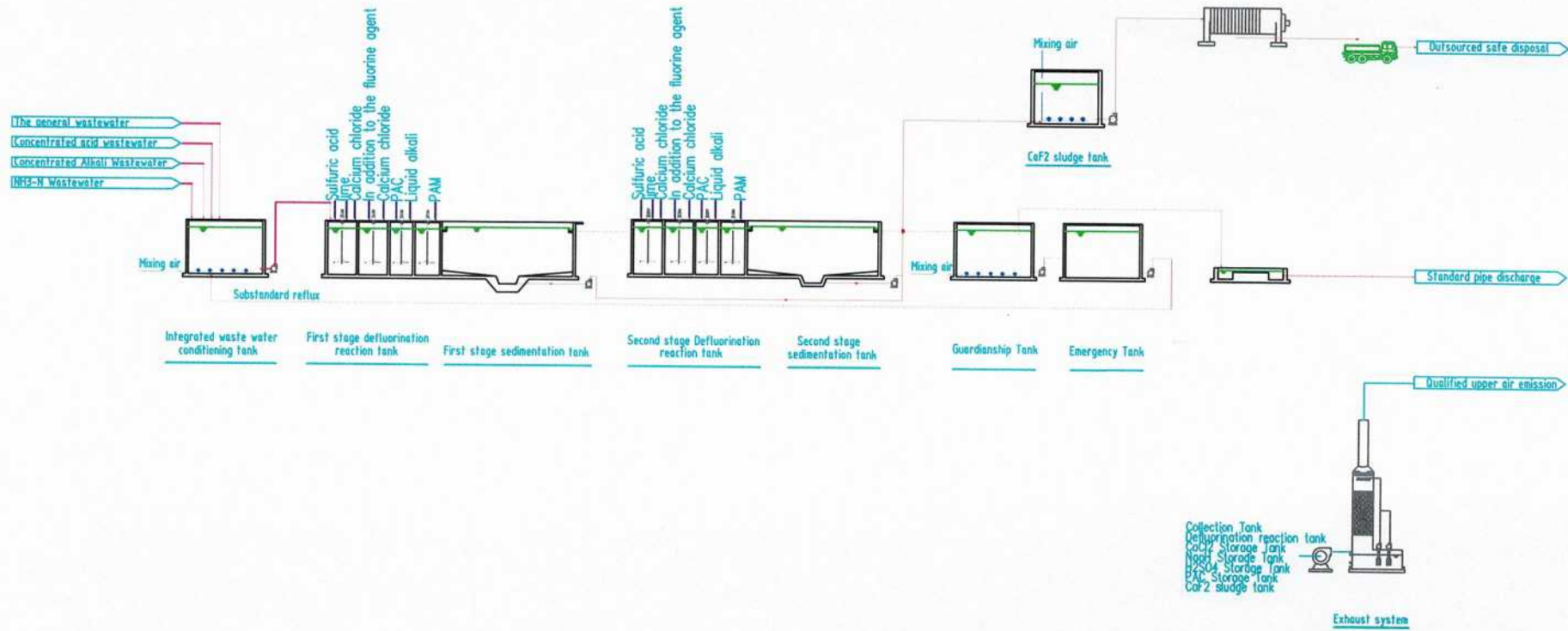
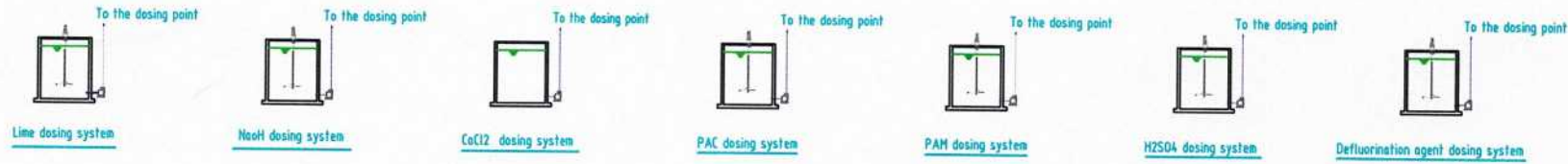
序号	建筑名称	占地面积(m ²)	建筑面积(m ²)	计容面积(m ²)
1	电厂厂房	2929.78	25466.56	49569.52
2	综合楼	3810.24	3914.64	3914.64
3	化学品库	720.00	720.00	720.00
4	燃气站	312.00	312.00	312.00
5	机修站	156.00	156.00	156.00
6	废水处理站	360.24	754.68	754.68
7	生产原料及水池	60.00	60.00	60.00
8	门卫及消防泵房水池	72.01	72.01	72.01
合计		3040.25	31272.29	55848.83

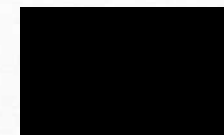
设计依据说明:

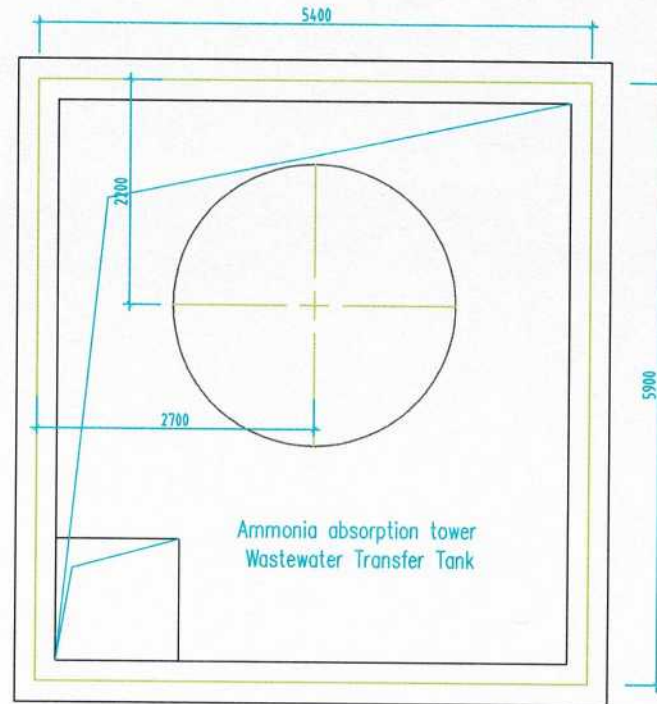
1. 本图依据国家和地方有关设计规范、标准和规定设计。
2. 本图依据当地有关部门提供的用地红线图设计。
3. 本图根据业主对本项目的设计要求设计。
4. 本图坐标系系统和高程基准依据业主提供的测绘坐标点和参照标高。
5. 本图尺寸单位为米。
6. 基地出入口应设置减速安全设施。

[illegible]

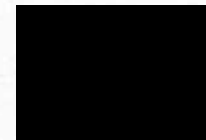


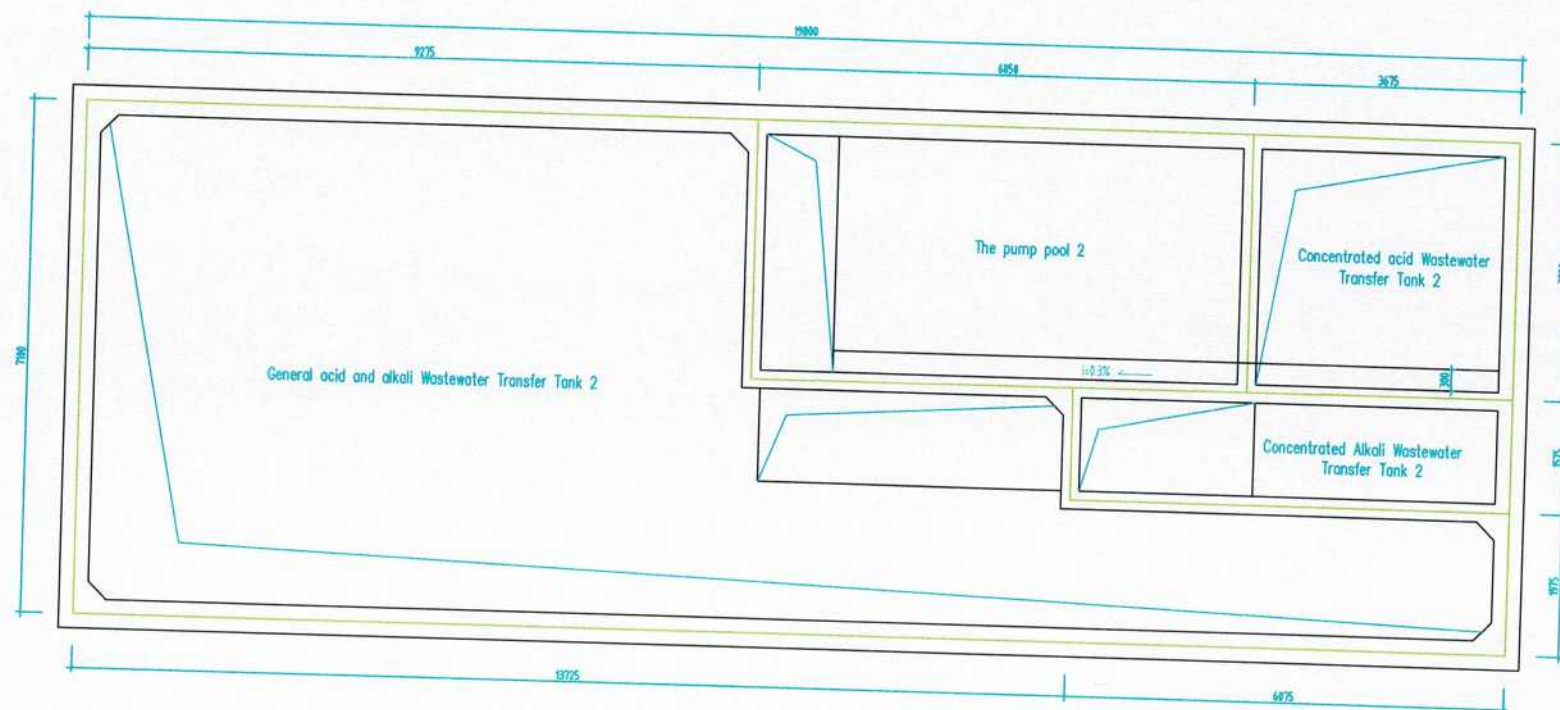




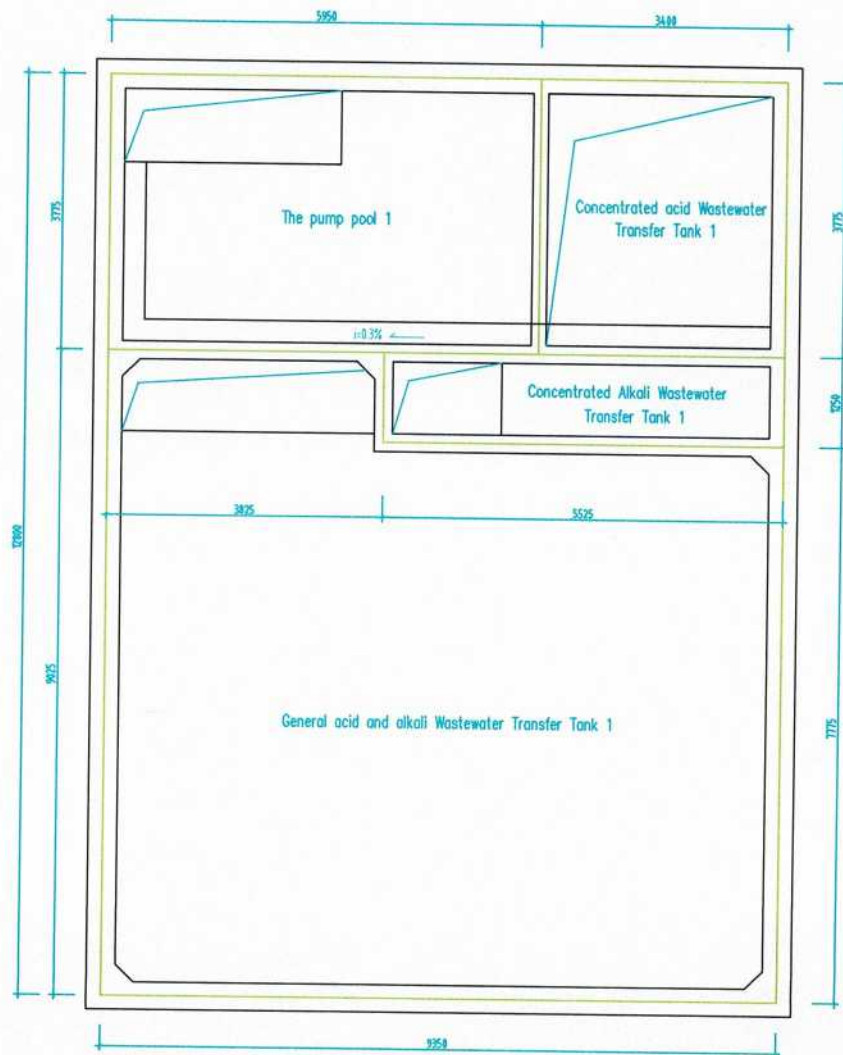


Wastewater collection pool 1 floor plan

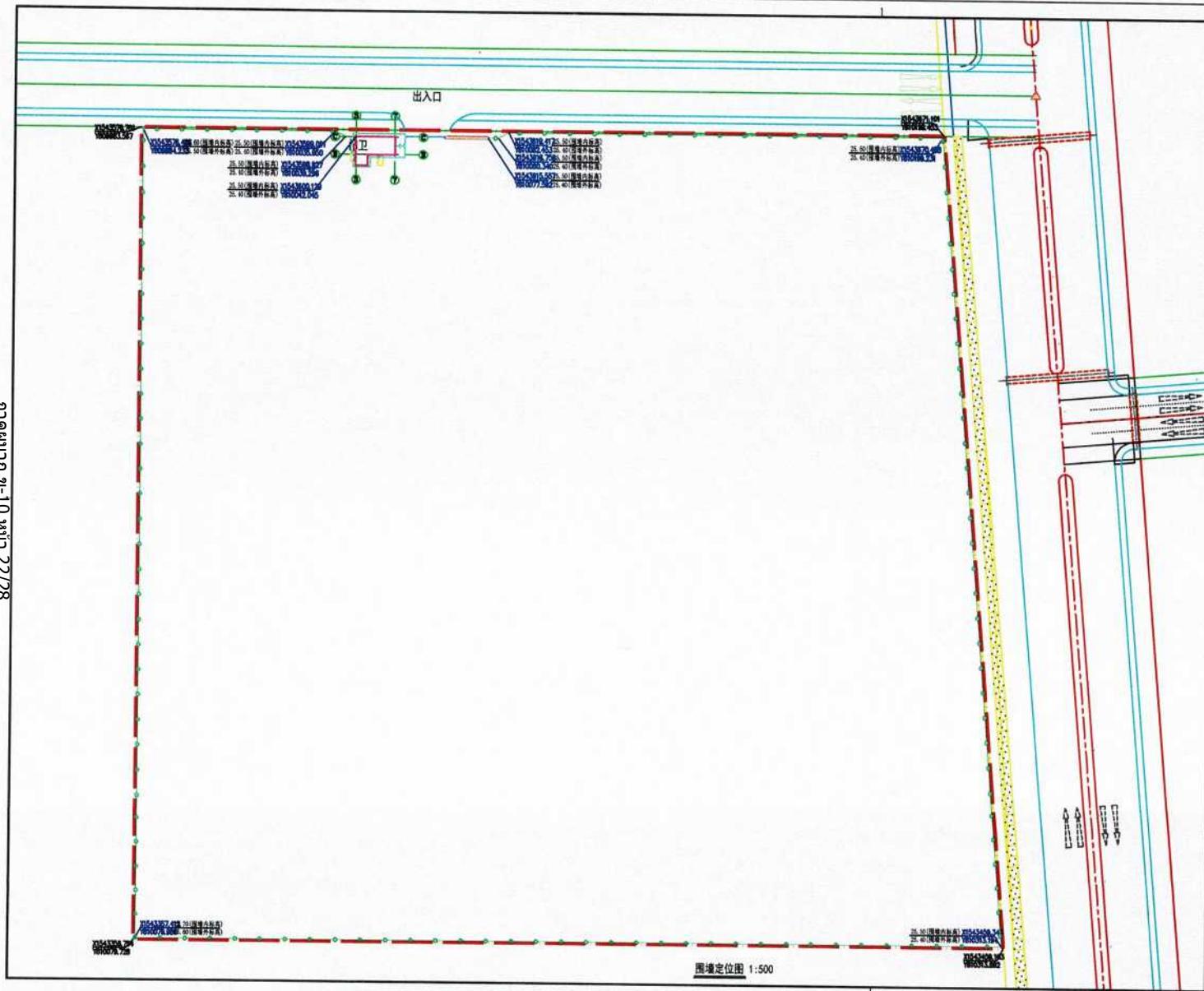




Wastewater collection pool2 floor plan



Wastewater collection pool 3 floor plan



围墙定位图 1:500



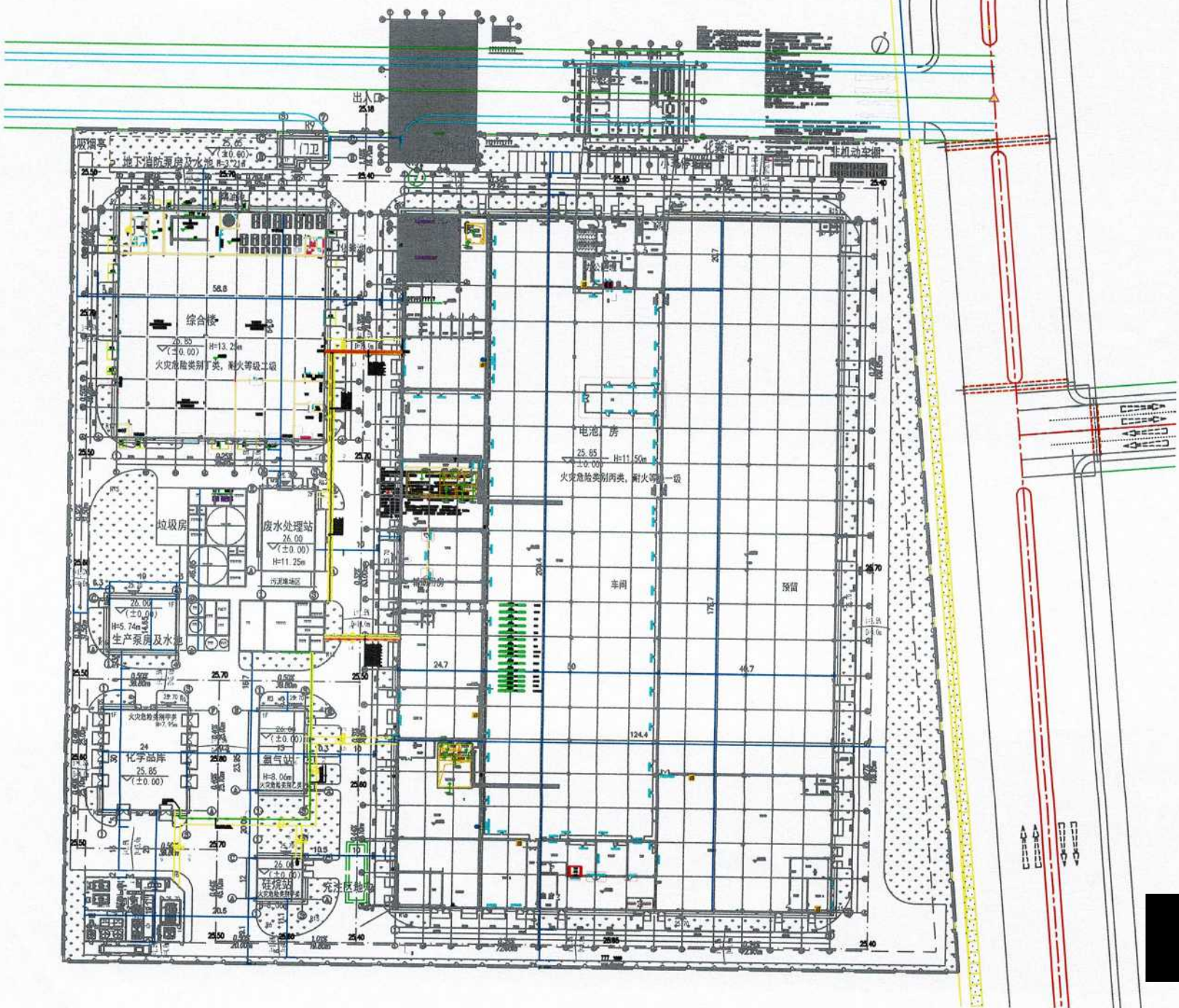
图 例		
序号	图例	名称
1		围墙及拐点坐标
2		围墙拐点场内标高 围墙拐点场外标高
3		用地范围

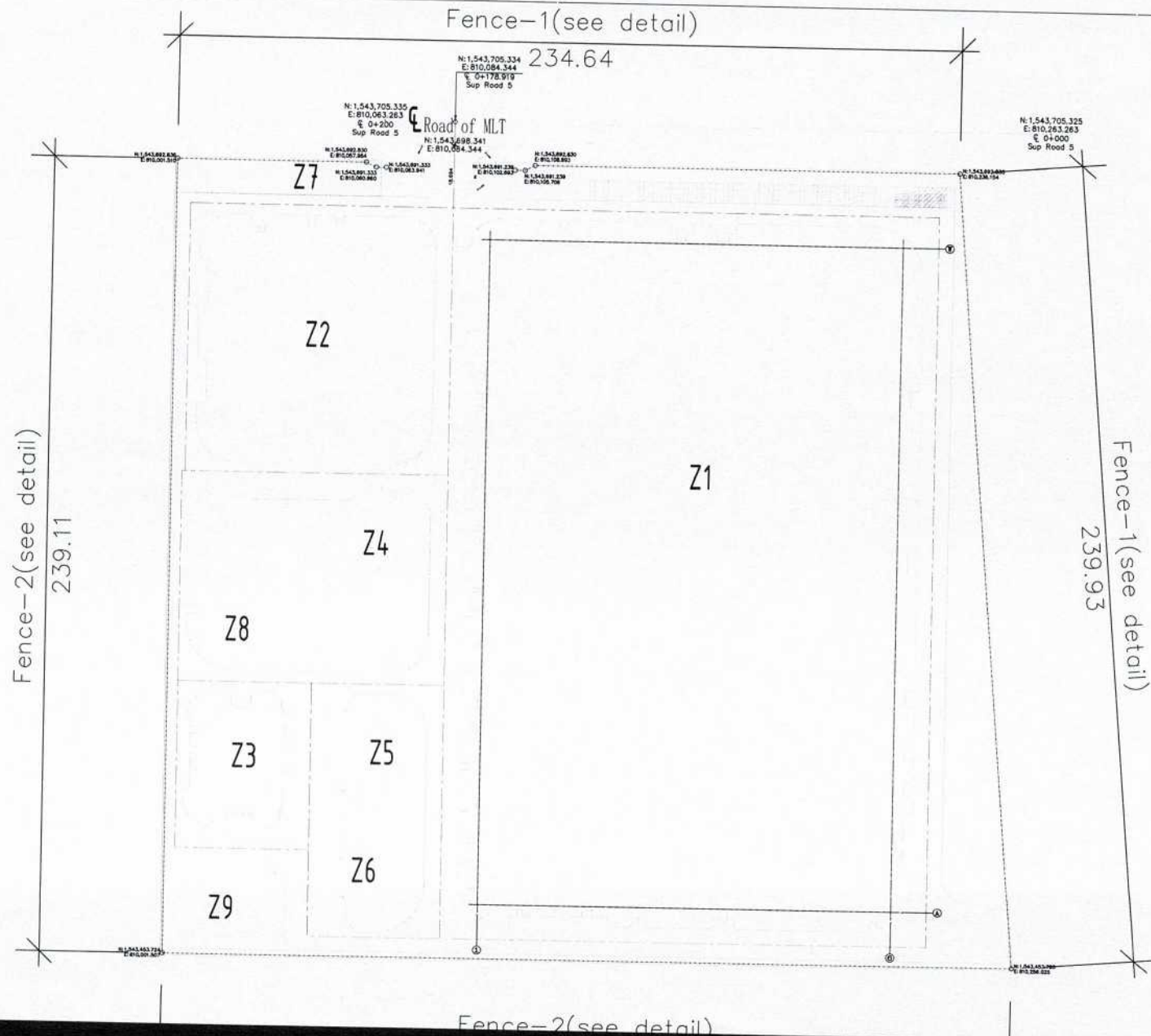
设计依据说明:

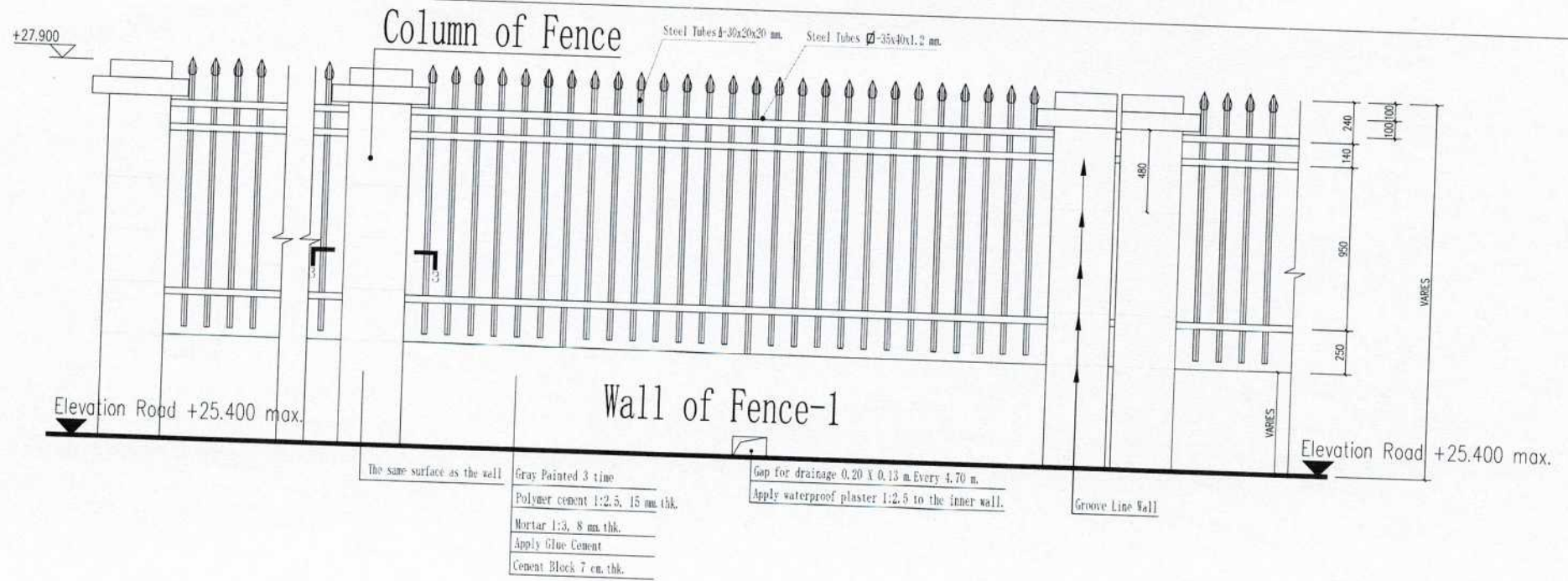
1. 本图依据国家和地方有关设计规范、标准和规定设计。
2. 本图依据当地有关部门提供的用地红线图、地形图和规划设计条件设计。
3. 本图根据业主对本项目的设计要求设计。
4. 本图坐标系系统和高程基准依据业主提供的测绘坐标点和参照标高。
5. 本图尺寸单位为米。
6. 图中所指围墙坐标为中心线交点坐标。
7. 围墙具体做法详见建筑专业图纸。

序号	姓名	职务
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

项目	内容
项目名称	围墙定位图
建设单位	中国联合工程有限公司
监理单位	中国联合工程有限公司
设计单位	中国联合工程有限公司
审核人	中国联合工程有限公司
审核日期	2021-08-28
审核人	中国联合工程有限公司
审核日期	2021-08-28
审核人	中国联合工程有限公司
审核日期	2021-08-28

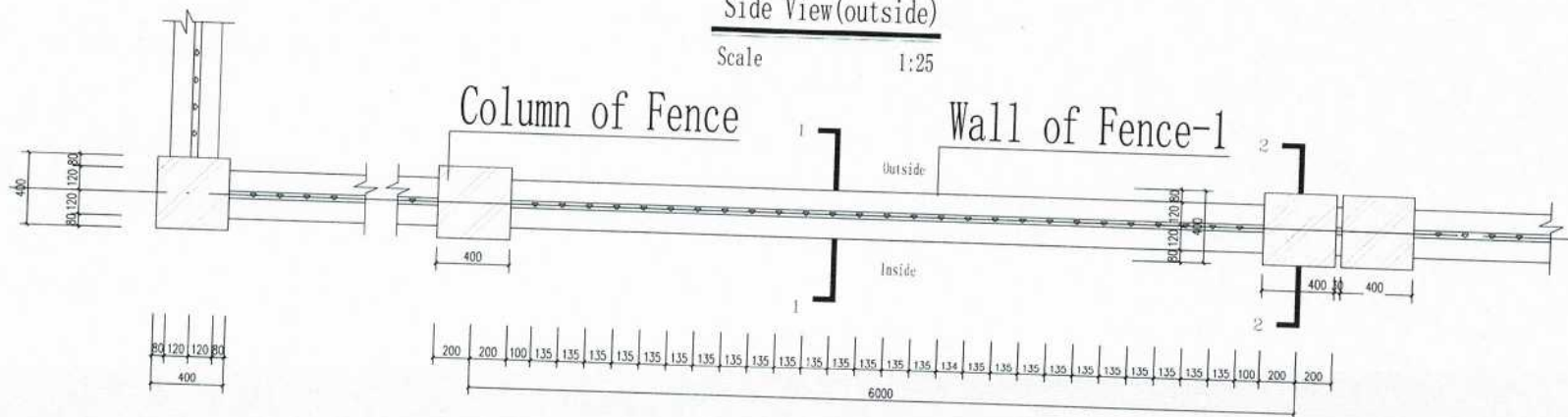






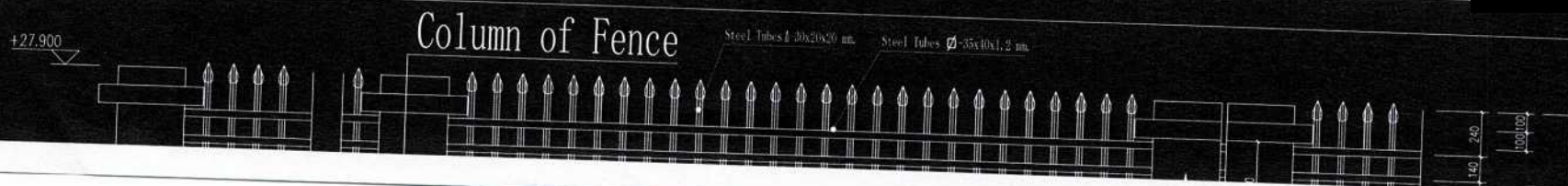
Side View(outside)

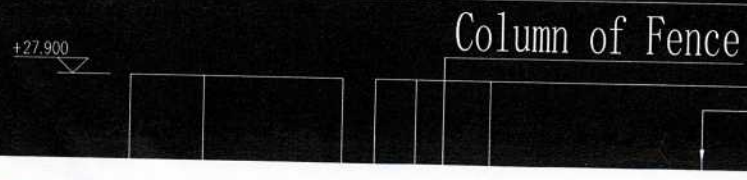
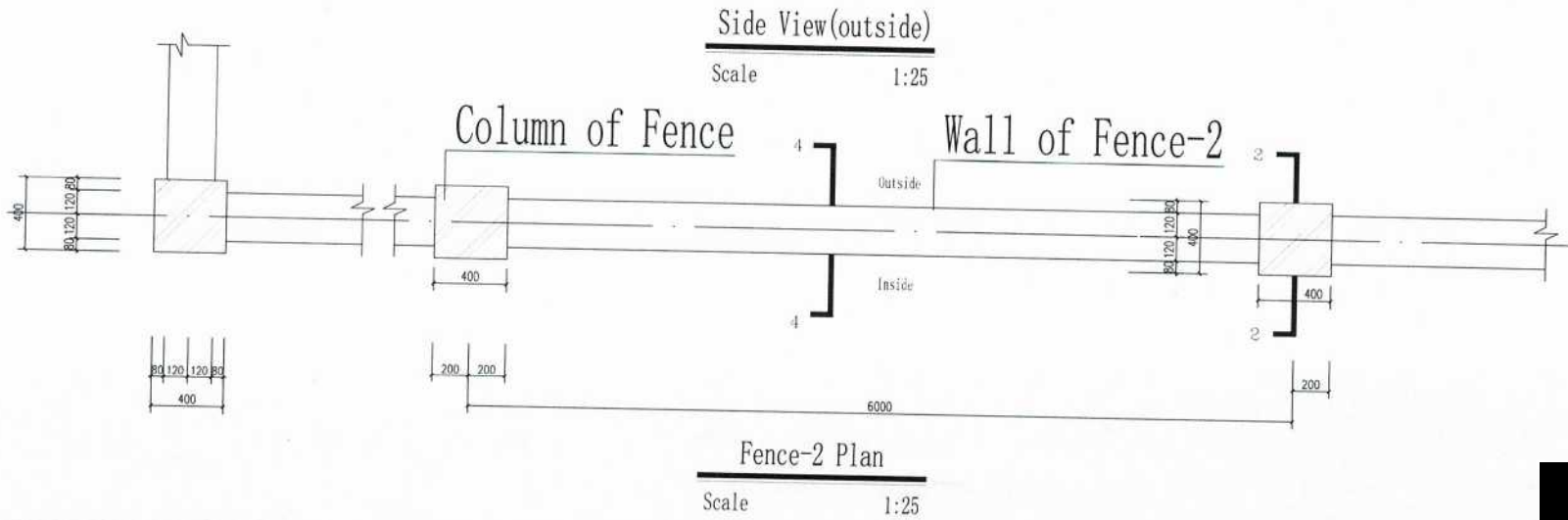
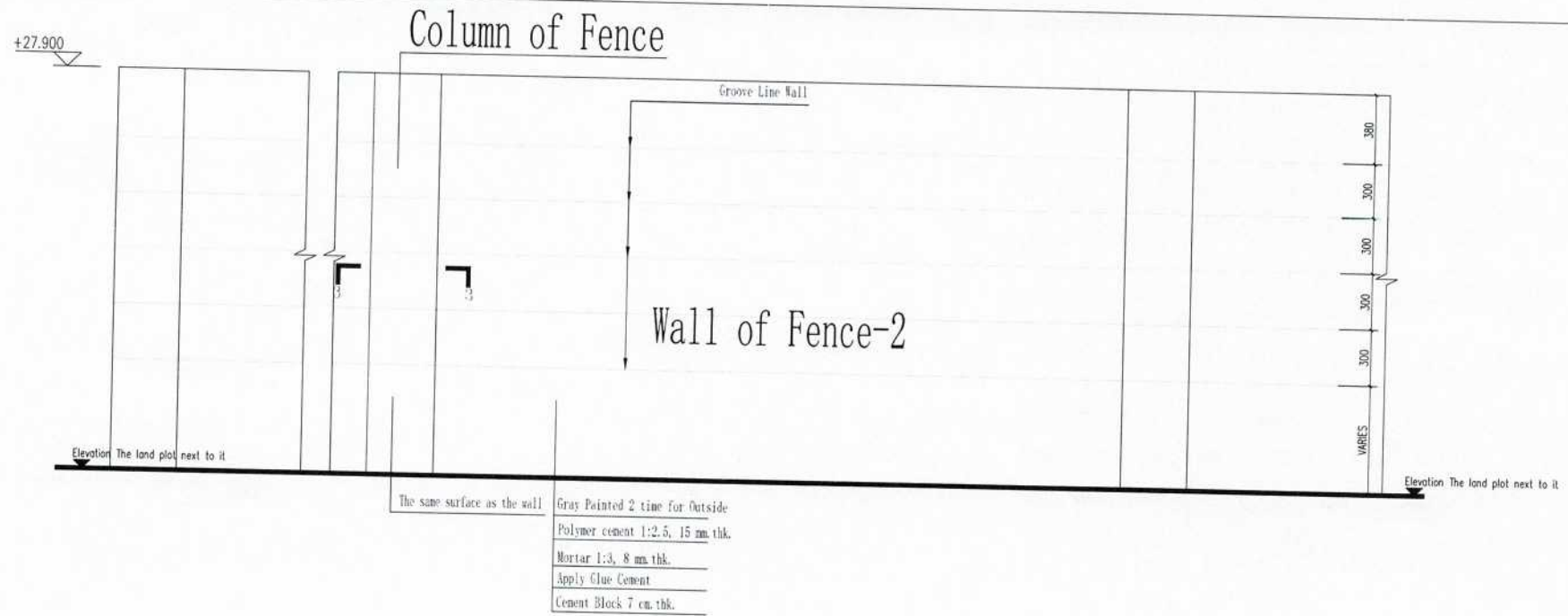
Scale 1:25

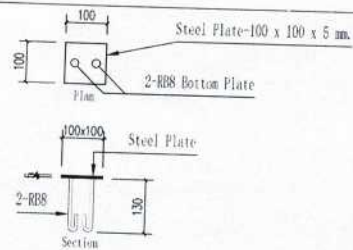


Fence-1 Plan

Scale 1:25

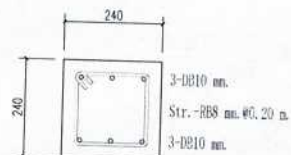






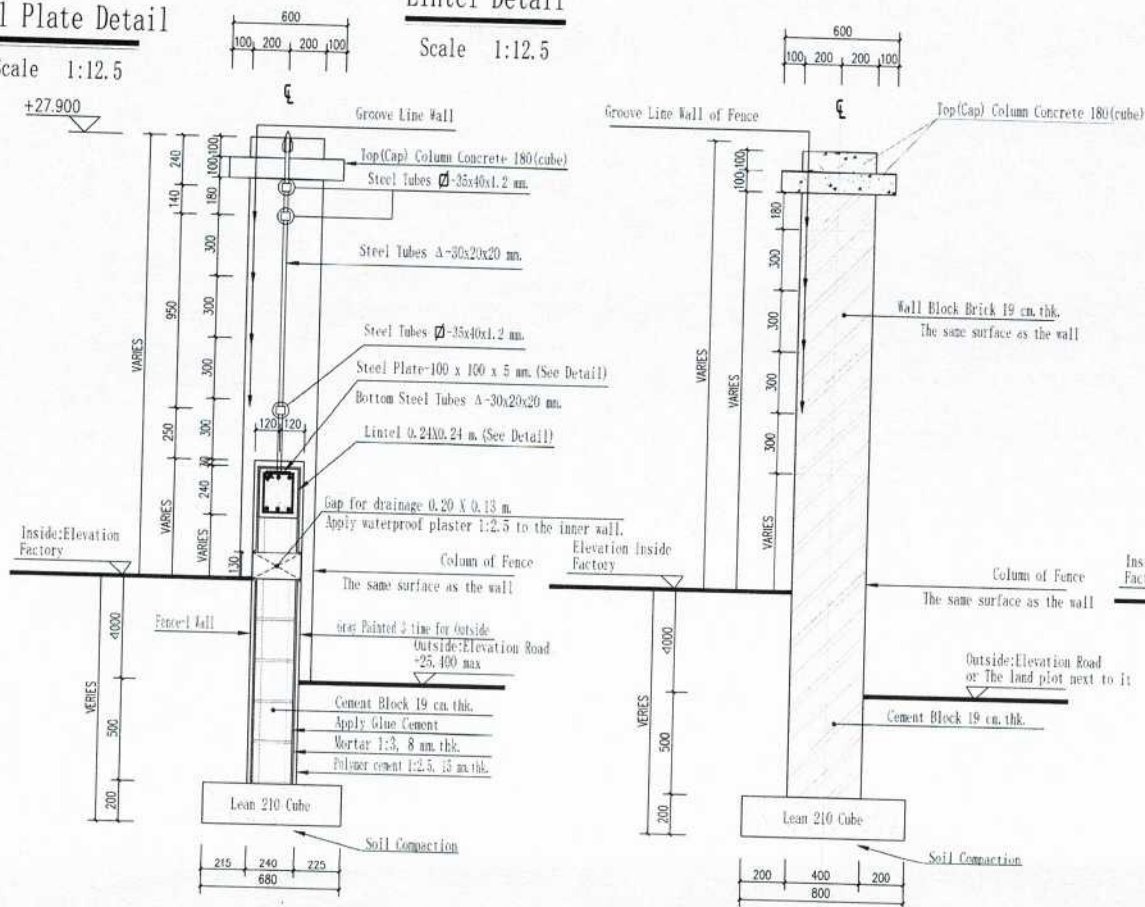
Steel Plate Detail

Scale 1:12.5



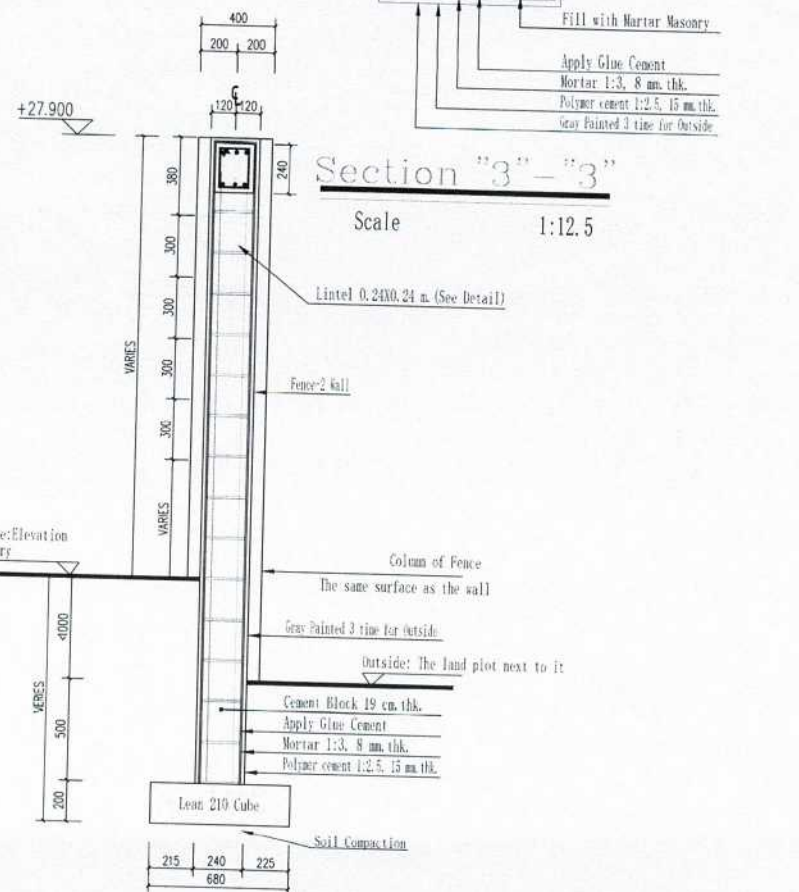
Lintel Detail

Scale 1:12.5



Section "1" - "1"

Scale 1.25



Section "3" - "3"

Scale 1:12.5

